كتالوج المنتجات

ترانزستورات قدرة RF



ترانزستورات قدرة RF هي عناصر شبه موصلة فعالة تحول الانحياز وإشارة القيادة RF إلى قدرة خرج داخل مرحلة تضخيم. تستخدم في مسارات الإرسال، وحدات القدرة النبضية أو المستمرة، معدات RF الصناعية ومنصات اختبار القدرة العالية.

المنتجات: 11

المراجعة: 10 · تاريخ المراجعة: 2026-11-11



LCT-5700-7100-PS51T

5700–7100 MHz GaN ترانزستور قدرة بمطابقة داخلية — PSAT 51 dBm (نموذجي)

5700–7100 MHz; PSAT 51 dBm (نموذجي); كسب القدرة 11 dB (نموذجي); PAE 45 % (نموذجي).

تردد التشغيل: الرمز: f; الحد الأدنى: 5700; الحد الأقصى: 7100; القيمة: 5700–7100; الوحدة: MHz

قدرة الخرج المشبعة: الحد الأدنى: 50.5; القيمة النموذجية: 51; الوحدة: dBm

كسب القدرة: الحد الأدنى: 10.5; القيمة النموذجية: 11; الوحدة: dB

كفاءة القدرة المضافة: الحد الأدنى: 40; القيمة النموذجية: 45; الوحدة: %

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS: من -3.2 V إلى -2.4 V (شامل للطرفين); PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 40 dBm

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCT-2700-3500-PS56p5T

2700–3500 MHz GaN ترانزستور قدرة بمطابقة داخلية — PSAT 56.5 dBm (نموذجي)

2700–3500 MHz; PSAT 56.5 dBm (نموذجي); كسب القدرة 13.5 dB (نموذجي); PAE 55 % (نموذجي).

تردد التشغيل: الرمز: f; الحد الأدنى: 2700; الحد الأقصى: 3500; القيمة: 2700–3500; الوحدة: MHz

قدرة الخرج المشبعة: الحد الأدنى: 56; القيمة النموذجية: 56.5; الوحدة: dBm

كسب القدرة: الحد الأدنى: 13; القيمة النموذجية: 13.5; الوحدة: dB

كفاءة القدرة المضافة: الحد الأدنى: 50; القيمة النموذجية: 55; الوحدة: %

TA = +25 °C; VDS = 44 V; VGS: من -4 V إلى -2 V (شامل للطرفين); D = 10%; PW = 300 µs; IDS = (0.2–0.5) IDSS

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCT-5300-5900-PS56p5T

5300–5900 MHz GaN ترانزستور قدرة بمطابقة داخلية — PSAT 56.5 dBm (نموذجي)

5300–5900 MHz; PSAT 56.5 dBm (نموذجي); كسب القدرة 12.5 dB (نموذجي); 45 % PAE (نموذجي).

تردد التشغيل: الرمز: f; الحد الأدنى: 5300; الحد الأقصى: 5900; القيمة: 5300–5900; الوحدة: MHz

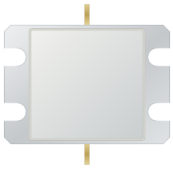
قدرة الخرج المشبعة: الحد الأدنى: 56; القيمة النموذجية: 56.5; الوحدة: dBm

كسب القدرة: الحد الأدنى: 12; القيمة النموذجية: 12.5; الوحدة: dB

كفاءة القدرة المضافة: الحد الأدنى: 40; القيمة النموذجية: 45; الوحدة: %

IDS = (0.2–0.5) IDSS; PW = 10 µs; D = 1% ;(شامل للطرفين) -2 V إلى -4 V من :TA = +25 °C; VDS = 40 V; VGS

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCT-2700-3900-PS48p5T

2700–3900 MHz GaN ترانزستور قدرة بمطابقة داخلية — PSAT 48.5 dBm (نموذجي)

2700–3900 MHz; PSAT 48.5 dBm (نموذجي); كسب القدرة 12.5 dB (نموذجي); 50 % PAE (نموذجي).

تردد التشغيل: الرمز: f; الحد الأدنى: 2700; الحد الأقصى: 3900; القيمة: 2700–3900; الوحدة: MHz

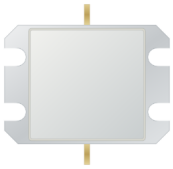
قدرة الخرج المشبعة: الحد الأدنى: 48; القيمة النموذجية: 48.5; الوحدة: dBm

كسب القدرة: الحد الأدنى: 12; القيمة النموذجية: 12.5; الوحدة: dB

كفاءة القدرة المضافة: الحد الأدنى: 45; القيمة النموذجية: 50; الوحدة: %

IDS = (0.2–0.5) IDSS ;(شامل للطرفين) -2 V إلى -4 V من :TA = +25 °C; VDS = 24–28 V; VGS

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCT-2700-3500-PS53p5T

2700–3500 MHz GaN ترانزستور قدرة بمطابقة داخلية — PSAT 53.5 dBm (نموذجي)

2700–3500 MHz; PSAT 53.5 dBm (نموذجي); كسب القدرة 13.5 dB (نموذجي); 65 % PAE (نموذجي).

تردد التشغيل: الرمز: f; الحد الأدنى: 2700; الحد الأقصى: 3500; القيمة: 2700–3500; الوحدة: MHz

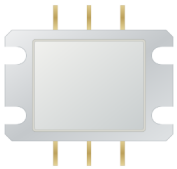
قدرة الخرج المشبعة: الحد الأدنى: 53; القيمة النموذجية: 53.5; الوحدة: dBm

كسب القدرة: الحد الأدنى: 13; القيمة النموذجية: 13.5; الوحدة: dB

كفاءة القدرة المضافة: الحد الأدنى: 60; القيمة النموذجية: 65; الوحدة: %

Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs ;(شامل للطرفين) -2 V إلى -4 V من :TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCT-2300-3900-PS50T

2300–3900 MHz GaN ترانزستور قدرة بمطابقة داخلية — PSAT 50 dBm (نموذجي)

2300–3900 MHz; PSAT 50 dBm (نموذجي); كسب القدرة 12 dB (نموذجي); 50 % PAE (نموذجي).

تردد التشغيل: الرمز: f; الحد الأدنى: 2300; الحد الأقصى: 3900; القيمة: 2300–3900; الوحدة: MHz

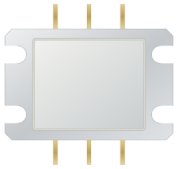
قدرة الخرج المشبعة: الحد الأدنى: 49; القيمة النموذجية: 50; الوحدة: dBm

كسب القدرة: الحد الأدنى: 11; القيمة النموذجية: 12; الوحدة: dB

كفاءة القدرة المضافة: الحد الأدنى: 45; القيمة النموذجية: 50; الوحدة: %

VDS = 24–28 V; IDS = (0.2–0.5) IDSS; VGS: TA = +25 °C: من -4 V إلى -2 V (شامل للطرفين)

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCT-2600-3700-PS49T

2600–3700 MHz GaN ترانزستور قدرة بمطابقة داخلية — PSAT 49 dBm (نموذجي)

2600–3700 MHz; PSAT 49 dBm (نموذجي); كسب القدرة 13 dB (نموذجي); 50 % PAE (نموذجي).

تردد التشغيل: الرمز: f; الحد الأدنى: 2600; الحد الأقصى: 3700; القيمة: 2600–3700; الوحدة: MHz

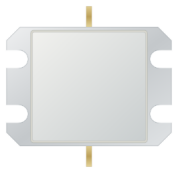
قدرة الخرج المشبعة: الحد الأدنى: 48; القيمة النموذجية: 49; الوحدة: dBm

كسب القدرة: الحد الأدنى: 12; القيمة النموذجية: 13; الوحدة: dB

كفاءة القدرة المضافة: الحد الأدنى: 45; القيمة النموذجية: 50; الوحدة: %

Pin = 36 dBm; CW; VGS = 28 V; TA = +25 °C: من -3.2 V إلى -2.2 V (شامل للطرفين)

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCT-8500-9600-PS51T

8500–9600 MHz GaN ترانزستور قدرة بمطابقة داخلية — PSAT 51 dBm (نموذجي)

8500–9600 MHz; PSAT 51 dBm (نموذجي); كسب القدرة 9 dB (نموذجي); 38 % PAE (نموذجي).

تردد التشغيل: الرمز: f; الحد الأدنى: 8500; الحد الأقصى: 9600; القيمة: 8500–9600; الوحدة: MHz

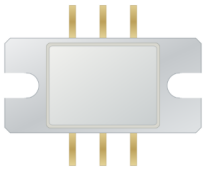
قدرة الخرج المشبعة: الحد الأدنى: 50; القيمة النموذجية: 51; الوحدة: dBm

كسب القدرة: الحد الأدنى: 8; القيمة النموذجية: 9; الوحدة: dB

كفاءة القدرة المضافة: القيمة النموذجية: 38; الوحدة: %

Vd = +28 V; Vg = -3 V; PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 42 dBm

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCT-2000-6000-PO45p51T

2000–6000 MHz GaN ترانزستور قدرة بمطابقة داخلية — Pout 45.51 dBm @ 6000 MHz (نموذجي)

2000–6000 MHz; قدرة الخرج المرجعية 45.51 dBm (نموذجي); كسب القدرة 19.51 dB (نموذجي); كفاءة المصرف 39.82 % (نموذجي) @ 6000 MHz.

تردد التشغيل: الرمز: f; الحد الأدنى: 2000; الحد الأقصى: 6000; القيمة: 2000–6000; الوحدة: MHz

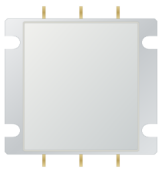
قدرة الخرج المرجعية: القيمة النموذجية: 45.51; الوحدة: dBm; ملاحظات: f = 6000 MHz

كسب القدرة: القيمة النموذجية: 19.51; الوحدة: dB; ملاحظات: f = 6000 MHz

كفاءة المصرف: الرمز: ηD; القيمة النموذجية: 39.82; الوحدة: %; ملاحظات: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 1.3 A; CW; f = 6000 MHz; Pin = 26 dBm

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCT-700-6200-PS49T

700–6200 MHz GaN ترانزستور قدرة بمطابقة داخلية — PSAT 49 dBm @ 6000 MHz (نموذجي)

700–6200 MHz; قدرة الخرج المشبعة 49 dBm (نموذجي); كسب القدرة 7 dB (نموذجي); كفاءة المصرف 35 % (نموذجي) @ 6000 MHz.

تردد التشغيل: الرمز: f; الحد الأدنى: 700; الحد الأقصى: 6200; القيمة: 700–6200; الوحدة: MHz

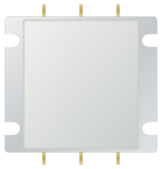
قدرة الخرج المشبعة: الرمز: Psat; القيمة النموذجية: 49; الوحدة: dBm; ملاحظات: f = 6000 MHz

كسب القدرة: القيمة النموذجية: 7; الوحدة: dB; ملاحظات: f = 6000 MHz

كفاءة المصرف: الرمز: ηD; القيمة النموذجية: 35; الوحدة: %; ملاحظات: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 1 A; CW; f = 6000 MHz

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCT-2000-6200-PO50p1T

2000–6200 MHz GaN ترانزستور قدرة بمطابقة داخلية — Pout 50.1 dBm @ 6000 MHz (نموذجي)

2000–6200 MHz; قدرة الخرج المرجعية 50.1 dBm (نموذجي); كسب القدرة 8.6 dB (نموذجي); كفاءة المصرف 52.4 % (نموذجي) @ 6000 MHz.

تردد التشغيل: الرمز: f; الحد الأدنى: 2000; الحد الأقصى: 6200; القيمة: 2000–6200; الوحدة: MHz

قدرة الخرج المرجعية: القيمة النموذجية: 50.1; الوحدة: dBm; ملاحظات: f = 6000 MHz

كسب القدرة: القيمة النموذجية: 8.6; الوحدة: dB; ملاحظات: f = 6000 MHz

كفاءة المصرف: الرمز: ηD; القيمة النموذجية: 52.4; الوحدة: %; ملاحظات: f = 6000 MHz

TA = +25 °C; VDS = 28 V; IDQ = 0.5 A; CW; f = 6000 MHz; Pin = 41.5 dBm

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.